

Номер реєстрації, який є номером свідоцтва	5
Дата реєстрації	15.06.2006
Номер заявки	t 2005 0002
Дата подання заявки	28.10.2005
Дата першого використання топографії ІМС	30.06.2004
Дата, з якої набирають чинності права, що засвідчуються свідоцтвом	15.06.2006
Дата публікації відомостей про реєстрацію топографії ІМС та номер бюлетеня	15.06.2006, Бюл. № 6
Заявник(и)	Товариство з обмеженою відповідальністю "НВО "Кристал"
Автор(и)	Ткаченко Володимир Олександрович, UA, Філь Віталій Ілларіонович, UA, Шельпук Георгій Данилович, UA, Сапон Сергій Васильович, UA
Власник(и)	Товариство з обмеженою відповідальністю "НВО "Кристал", Залізничне шосе, 57, м. Київ, 01103
Назва топографії ІМС	ТРИВИДНИЙ СТАБІЛІЗАТОР ПОЗИТИВНОЇ НАПРУГИ MC78XX-Cr
Адреса для листування	ТОВ "НВО "Кристал", Тімонтьєв В. М., п/с 22, м. Київ, 04078

Реферат:

Назва ІМС -Трививідний стабілізатор позитивної напруги МС78XX-Сг.

Найменування заявника - Товариство з обмеженою відповідальністю "НВО "Кристал".

Галузь застосування - джерела живлення радіоелектронної апаратури.

Призначення - стабілізація напруги живлення радіоелектронної апаратури. Стабілізатор забезпечує ряд фіксованих вихідних напруг 5В, 6В, 8В, 9В, 12В, 15В, 18В і 24В при вихідному струмі до 1А і вхідній напрузі до 45В. Конкретна вихідна напруга забезпечується вибором необхідного шаблону шару комутуючих металевих з'єднань.

Вид технології – технологія виготовлення ІМС з біполярними транзисторами, іоннолегованими резисторами, МОН-конденсаторами та з ізоляцією елементів р-п-переходом.

Ознакою топографії, яка є новизною, і становить собою предмет заявки, є оригінальність конструкції елементів схеми електричної ІМС і оригінальність розташування елементів на кристалі ІМС. Оригінальність конструкції елементів і їх розташування на кристалі ІМС забезпечили необхідні електричні параметри ІМС при більшій щільності упаковки кристала, що дозволило збільшити число елементів схеми на одиниці площі кристала. Кінцевим результатом такого підходу є зменшення габаритів кристала. Економічний ефект полягає в збільшенні знімання придатних кристалів з однієї пластинки при незмінній витраті робочого часу, енергоресурсів і витратних матеріалів.

Дата та місце першого використання топографії ІМС - 30.06.2004, Україна.

Основні технічні характеристики кристала:

- ряд вихідних напруг - 5В, 6В, 8В, 9В, 12В, 15В, 18В, 24В;
- максимальний вихідний струм -1 А;
- падіння напруги між входом і виходом, при вихідному струмі 1А - 1,7В;
- внутрішній захист від перегріву ІМС;
- внутрішній захист від перевантаження по вихідному струму.